









 	<h2 style="color: red;">FQD4N20LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD4N20LTF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD4N20LTF.pdf 2.FQD4N20LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N20LTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.35 Ohm @ 1.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD4N20LTF ist neu im Original, Suche FQD4N20LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4N20LTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4N20LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD4N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p>FQD3P50TM_NL Fairchild/ON Semiconductor FQD3P50TM_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD4N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>
 <p>FQD45N03L F F TO-252</p>	 <p>FQD4N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>	 <p>FQD4N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>	 <p>FQD4N20 F FQD4N20 F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD3N40TM	↔ FQD3N40TM	⇒ FQD3N50C	D FQD3N50C/CS	↔ FQD3N50CTF
⊣ FQD3N50CTF	⊗ FQD3N50CTM	D FQD3N50CTM	⇒ FQD3N60C	↔ FQD3N60CS
⊗ FQD3N60CTF	⊣ FQD3N60CTM	⊗ FQD3N60CTM_WS	↔ FQD3N60TF	↔ FQD3N60TF
D FQD3N60TM	⊗ FQD3N60TM	⊣ FQD3P20TF	⊗ FQD3P20TF	↔ FQD3P50TF
⇒ FQD3P50TF	↔ FQD3P50TM	⊗ FQD3P50TM	⊣ FQD4N20L	↔ FQD4N20LTF
↔ FQD4N20TF	⇒ FQD4N20TF	D FQD4N20TM	⊗ FQD4N20TM	⊣ FQD4N25TM
⊗ FQD4N25TM	D FQD4N50S	⇒ FQD4N50T	↔ FQD4N50TF	↔ FQD4N50TF
⊣ FQD4N50TM	⊗ FQD4N50TM	↔ FQD4N60C	⇒ FQD4N60CTM	↔ FQD4N65C
⊗ FQD4P25TM	⊣ FQD4P25TM	⊗ FQD5N15TF	D FQD5N15TF	↔ FQD5N15TM
↔ FQD5N15TM	⊗ FQD5N20L	⊣ FQD5N20LTM	⊗ FQD5N20LTM	↔ FQD5N20TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited